

5月24日(水)

- 強誘電体材料() (座長) 坂部 行雄 (村田製作所) 10:30--12:00
- (24-F-1) $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - PbZrO_3 系強誘電酸化物の誘電的・圧電的性質
(いわき明星大学理工) 横須賀 勝
- (24-F-2) PZTセラミックスの材料組成が3次非線形圧電定数に及ぼす影響
(防衛大学) 村田 敏郎、石井 啓介、田代 新二郎、五十嵐 秀二
- (24-F-3) 複合添加物 Li_2CO_3 - Bi_2O_3 - CdCO_3 添加により低温焼結された高性能PNS - PNN - PZTセラミックス
(静岡大電子研、*静岡大工) 王 小興、村上 健司、金子 正治*
- (24-F-4) Dielectric, Pyroelectric and Piezoelectric Properties of $0.7\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - 0.3PbTiO_3 Ceramics Modified with Ag_2O
(Dankook Univ.) G. B. Kim, S. W. Choi
- (24-F-5) Structural and Dielectric Studies of the Phase Transitions in $\text{Pb}(\text{Yb}_{1/2}\text{Ta}_{1/2})\text{O}_3$ - PbTiO_3 Ceramics
(KAIST) S. B. Park, W. K. Choo
- (24-F-6) Correlation of Internal Friction and Dielectric Measurements in PZT Ferroelectric Ceramic
(National Institute for Research in Inorganic Materials, *Institut National des Sciences Appliquees) E. M. Bourim, H. Tanaka, M. Gabbay*, G. Fantozzi*
- 薄膜 (座長) 塩寄 忠 (奈良先端科学技術大学院大) 13:15--14:45
- (24-T-1) マグネトロンスパッタで製膜された複合酸化物薄膜の組成分布の解析
(富士電機総研) 小西 義則、原田 恵子
- (24-T-2) 分極反転に伴う強誘電体 $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ 薄膜の反転分極量の増加
(奈良先端大物質) 岡村 総一郎、高岡 将樹、西田 貴司、塩寄 忠
- (24-T-3) Hydrogen Barrier of Integrated $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ Ferroelectric Capacitor for Conventional PE- SiO_2 /PE- Si_3N_4 Passivation
(Hyundai Electronics Industries) C. W. Suh, S. K. Hong, C. G. Lee, S. W. Lee, Y. M. Kang, B. Yang, N. S. Kang, J. M. Hwang
- (24-T-4) Structural Identification and Electrical Properties of the New Pyrochlore Phase in the Sr-Bi-Ta-Ti-O System
(National Taiwan University) C.-H. Lu, B.-K. Fang, C.-Y. Wen
- (24-T-5) Effects of Crystallization annealing Sequence on Morphology of $\text{Pt}/\text{SrBi}_2(\text{Ta},\text{Nb})_2\text{O}_9$ Interface and Electrical Properties of Ferroelectric Capacitor
(Hyundai Electronics Industries) W. S. Yang, S. J. Yeom, J. S. Roh, C. T. Kim

- (24-T-6) Phase Formations and Electrical Properties of $(\text{Sr}_x\text{Ba}_{1-x})\text{Bi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ Thin Films
 (Micro-Electronics Technology Laboratory, Electronics and Telecommunications Research Institute) W.-J. Lee, I.-K. You, I.-S. Yang, B.-G. Yu, K.-I. Cho
 圧電材料() (座長) 竹中 正 (東京理科大学) 15:00--16:15
- (24-P-1) KNbO_3 単結晶厚み縦振動子の圧電特性
 (東北大工) 中村 信良、川村 佳子、常盤 豪
- (24-P-2) 高いキュリー温度を有するモルフォトロピック相境界近傍のインジウムニオブ酸鉛 - チタン酸鉛
 2成分系固溶体単結晶の圧電特性の温度依存性
 (岐阜大工、*東芝、**名大工、***愛知淑徳大ビジネスコミュニケーション) 安田 直彦、大和 英弘、長谷川 大裕、林 浩司、細野 靖晴*、山下 洋八*、岩田 真**、石橋 善弘***
- (24-P-3) スカンジウムニオブ酸鉛-マグネシウムニオブ酸鉛-チタン酸鉛3成分系圧電単結晶の育成
 とその電気的特性
 (東芝、*Simon Fraser Univ.) 細野 靖晴、原田 耕一、山下 洋八、Z.-G. Ye*
- (24-P-4) ペロブスカイト化合物の分子量が電気機械結合係数に与える効果
 (東芝、*早大理工) 山下 洋八、細野 靖晴、原田 耕一、一ノ瀬 昇*
- (24-P-5) The Growth of New Piezocrystal PMNT
 (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences) H. Luo, G. Xu, H. Xu, P. Wang, Z. Yin
 薄膜() (座長) 清水 勝 (姫路工業大学) 16:30--18:00
- (24-T-7) MOCVD法によるPt/(Ti,Al)N/TiN/Si基板上へのエピタキシャルPZT薄膜の作製と評価
 (村田製作所) 櫻井 敦、李 効民、白露 幸祐、田中 克彦、坂部 行雄
- (24-T-8) ガラス基板上への $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ 薄膜の作製と評価
 (東芝) 日置 毅、秋山 政彦、上田 知正、原 雄二郎、小野塚 豊、鈴木 幸治
- (24-T-9) LB膜を前駆体とするPZT超薄膜の作製
 (電気磁気材料研究所、*東北工業技術研究所、**東北大金研) 菅井 弘、高広 克己**、飯島 高志*、増本 博**
- (24-T-10) Si基板上への $\text{PbTiO}_3/\text{Pt}/\text{YSZ}$ ヘテロエピタキシャル膜の作製
 (東工大総合理工、*ジャパンエナジー) 時田 浩司、星 英夫*
- (24-T-11) MOCVD法による $\text{PbZr}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$ 薄膜の成長初期過程の観察
 (姫路工大、*富士通) 藤沢 浩訓、森本 浩司、村上 幸平、清水 勝、丹生 博彦、本田 耕一郎*、大谷 成元*

(24-T-12) Preparation and Properties of Perovskite $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ Thin Films on YSZ(111)/Si(111) Substrates by Post-Deposition Annealing

(Kanazawa Univ.) J.-D. Kim, S. Hana, K. Sasaki, T. Hata

5月25日(木)

薄膜() (座長) 宮坂 洋一 (日本電気(株)) 9:00--10:15

(25-T-13) アルコキッド法による層状ペロブスカイト $\text{CaBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ 強誘電体薄膜の作製

(名古屋工業技術研究所・東工大) 加藤 一美

(25-T-14) マルチレイヤ法を利用した $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ 薄膜の配向制御

(早大理工、*沖電気、**東京応化工業) 吉江 智寿、星加 武史、逢坂 哲彌、小岩 一郎*、澤田 佳宏**、橋本 晃**

(25-T-15) $\text{SrBi}_2(\text{Ta}_{1-x}\text{Nb}_x)_2\text{O}_9$ 薄膜におけるフローライト構造の判別法と評価

(日本フィリップス、*東工大・物創) 齊藤 啓介、三宅 まり子、山路 功、赤井 孝夫、三矢 昌俊*、石川 勝之*、額賀 紀全*、舟窪 浩*

(25-T-16) PLD法による $\text{Sr}_2(\text{Ta}_{1-x}\text{Nb}_x)_2\text{O}_7$ 薄膜の作製と評価

(阪大基礎工) 中磯 俊幸、杉山 秀樹、野田 実、奥山 雅則

(25-T-17) RFスパッタによる大口径基板上 $\text{SrBi}_2\text{Ta}_{1.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_9$ 強誘電体薄膜の形成

(日本真空) 増田 健、宮口 有典、西岡 浩、鄒 紅コウ、S. Sun

薄膜() (座長) 田畑 仁 (大阪大学) 10:30--12:00

(25-T-18) PZT/LSMOヘテロ構造膜の強誘電性と巨大磁気抵抗特性

(熊本大工、*ノースカロライナ州大、**スウェーデン王立工大) 光木 文秋、山形 幸彦、池上 知顯、蛭原 健治、J. Narayan*、A. M. Grishin**

(25-T-19) エピタキシャルPZT/Ir/ZrN/Si構造の強誘電体特性

(北陸先端大) 堀井 貞義、横山 政司、堀田 將

(25-T-20) AFM歪み測定によるPLZTキャパシタのインプリント現象の評価

(富士通) 吉田 親子、田村 哲朗

(25-T-21) 低電圧動作PZT薄膜の作製とその評価

(三菱マテリアル) 曾山 信幸、牧 一誠、森 暁、小木 勝実

(25-T-22) CSD法により作製したAlドーパPZT薄膜の強誘電特性

(東北工業技術研究所、*ヤマハ) 飯島 高志、何 崗、王 征、坪井 秀樹*、樋山 邦夫*、岡田 升宏*

- (25-T-23) レーザーアブレーション法により作製したPZT薄膜の電気的特性に及ぼすターゲットの鉛組成の影響
(工業技術院機械技術研究所) 王 占杰、菊地 薫、前田 龍太郎
- 強誘電体材料() (座長) 林 卓 (湘南工科大学) 13:15--14:45
- (25-F-7) 単結晶LiTaO₃の選択的再単分域化処理と評価
(松下電工) 柳生 博之・松嶋 朝明
- (25-F-8) ビスマス系ペロブスカイト酸化物の誘電的特性
(早大理工) 渡邊 優、一ノ瀬 昇
- (25-F-9) SrBi₂Ta₂O₉ セラミックの作製とその特性
(足利工大、*東理大理工) 荘司 和男、柴田 和生、中山 徹、坂田 好一郎*
- (25-F-10) Ho-Mg及びHo-Mnを添加したチタン酸バリウム の固溶サイトと誘電特性
(太陽誘電、*名工大) 岸 弘志、神津 典之、井口 喜章、杉野 順一*、大里 齊*、奥田 高士*
- (25-F-11) Ca(TiZr)O₃系積層セラミックスコンデンサの信頼性におよぼす微細構造の影響
(村田製作所) 元木 智雄、内藤 正浩、佐野 晴信、鴻池 健弘、伴野 国三郎
- (25-F-12) 積層セラミックコンデンサの電気特性及び信頼性における誘電体層数依存性
(TDK) 中野 幸恵、増田 健、野村 武史
- 薄膜() (座長) 阿部 和秀 (株式会社東芝) 15:00--16:15
- (25-T-24) 高ガス圧スパッタリングによるエピタキシャルBaTiO₃膜の作製
(東芝) 安本 恭章、梁瀬 直子、阿部 和秀、川久保 隆
- (25-T-25) (Ba,Sr)TiO₃薄膜堆積に対する気相反応の影響
(京大工) 百瀬 俊、佐原 隆介、中村 敏浩、橘 邦英
- (25-T-26) MOCVD法により作製した(Ba,Sr)TiO₃薄膜特性の膜厚依存性
(村田製作所) 竹島 裕、田中 克彦、坂部 行雄
- (25-T-27) 枚葉型溶液気化CVDリアクタを用いた(Ba,Sr)TiO₃薄膜の安定成膜
(三菱電機) 堀川 剛、山向 幹雄、多留谷 政良、川原 孝昭、大森 達夫
- (25-T-28) MOCVD Deposition of BST Thin Films for Future DRAM Applications
(AIXTRON) J. Lindner, M. Schumacher, F. Schienle, D. Burgess, P. Strzyzewski, H. Jurgensen

特別講演 (座長) 石橋 善弘 (愛知淑徳大学) 16:30--17:30
(25-I-1) 私のFMA昔話 - 圧電PZTとコンポジット -
(日本特殊陶業) 坂野 久夫

5月26日(金)

圧電材料() (座長) 戸田 耕司 (防衛大学校) 9:00--10:15
(26-P-6) 界面重合法によるPZT厚膜の作製とその電気的特性
(東工大理工) 鶴見 敬章、小澤 修一、和田 智志、山根 正之
(26-P-7) $\text{PbNi}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$ - PbTiO_3 - PbZrO_3 系積層圧電体の試作
(富士通) 近藤 正雄、肥田 勝春、表 孝司、谷口 修、三田 剛、梅宮 茂良、栗原和明
(26-P-8) スクリーン印刷法による鉛系強誘電体厚膜の低温形成
(*富山県工業技術センター、富山県立大工) 二口 友昭*、中野 州崇、安達 正利
(26-P-9) 厚塗り及び薄塗りゾルゲル液によるPZT厚膜の作製と評価
(三菱マテリアル) 牧 一誠、曾山 信幸、森 暁、小木 勝実
(26-P-10) ゾルゲルキャスト法によるPZT厚膜の低温形成
(静岡大工、*湘南工大) 大野 智也、国枝 雅文、鈴木 久男、林 卓*

圧電材料() (座長) 一ノ瀬 昇 (早稲田大学) 10:30--12:00
(26-P-11) 低温焼結性PZT-Pb(Ni,Nb) O_3 セラミックスの圧電特性
(村田製作所) 林 宏一、白露 幸祐、安藤 陽、坂部 行雄
(26-P-12) Actuation Properties of PZT Thick Films Structured on Si Membranes by Aerosol Deposition Method
(工業技術院 機械技術研究所、**リコー、*科学技術振興事業団) レベデフ マキシム*、明渡 純、秋山 善一**
(26-P-13) チタン酸鉛セラミックスの結晶配向度および強誘電特性の分極電界依存
(静岡理工科大) 小川 敏夫
(26-P-14) ビスマス層状構造強誘電体 $\text{Sr}_{m-3+x}\text{Bi}_{4-x}\text{Ti}_{m-x}\text{Ta}_x\text{O}_{3m+3}$ の圧電的性質
(東理大理工) 永田 肇、高橋 剛士、宮村 俊輔、竹中 正
(26-P-15) ビスマス層状構造強誘電体セラミックスの配向組織制御とその圧電特性
(豊田中研) 竹内 嗣人、斎藤 康善、谷 俊彦
(26-P-16) $\text{SrBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ 系セラミックスの厚みすべり振動特性
(TDK) 岡 均、廣瀬 正和、塚田 岳夫、渡邊 康夫、野村 武史

- 薄膜() (座長) 増田 陽一郎 (八戸工業大学) 13:15--14:45
- (26-T-29) 強誘電体キャパシタの多層配線工程における劣化挙動及びSrRuO₃電極による劣化抑制効果の検証
(東芝) 日高 修、國島 巖
- (26-T-30) 強誘電体キャパシターに対するCat-CVD法を用いた活性アンモニア処理における基板冷却効果
(石川県工業試験所、*ローム、**北陸先端大) 南川 俊治、米澤 保人、中村 孝*、藤森 敬和*、増田 淳**、松村 英樹**
- (26-T-31) Pb(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O₃膜の結晶化に及ぼすBaPbO₃基板の効果
(九工大工) 高橋 誠治、高田 省三、古曳 重美
- (26-T-32) エピタキシャル(Pb,La)(Zr,Ti)O₃薄膜の強誘電特性に及ぼすPt/SrRuO₃上部電極の効果
(姫路工大・応用化学、*姫路工大 電子工学) 小舟 正文、松浦 修武、松崎 智昭、嶺重 温、藤井 知、藤澤 浩訓*、清水 勝*、丹生 博彦*
- (26-T-33) 走査型プローブ顕微鏡を用いた(Pb,La)TiO₃薄膜の電界誘起歪みの測定
(湘南工大工、*早大理工) 真岩 宏司、一ノ瀬 昇*
- (26-T-34) Ferroelectric Properties of Thick Pb(Zr_{1-x}Ti_x)O₃ Films Prepared by Pulsed Laser Deposition
(National Tsing-Hua Univ., *National Taiwan Normal Univ.) C.-S. Lin, H.-H. Wang, I-N. Lin, H.-F. Cheng*

- 薄膜() (座長) 塚本 桓世 (東京理科大学) 15:00--16:00
- (26-T-35) TiおよびZrアルコキンドを用いたゾル・ゲル法による強誘電体BaTi_{0.91}(Hf_{0.5},Zr_{0.5})_{0.09}O₃薄膜の作製と評価
(東理大基礎工、*防衛大学校) ジラワット トングルアン、西尾 圭史、土谷 敏雄、永田 邦裕*
- (26-T-36) Ti-siteを置換したBaTiO₃薄膜の成膜とその強誘電特性
(八戸工大) 掛本 博文、柿本 健一、藤田 成隆、増田 陽一郎
- (26-T-37) Sidewall-fence-free Etching Using Rounded Shape Resist in Rie Reactor
(Hyundai Electronics Industries) J. H. Cho, Y. S. Seol, J. W. Kim, J. M. Hwang
- (26-T-38) Influence of La_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃ Heterostructure Electrodes on Pb(Zr,Ti)O₃ Thin Film Properties
(KAIST) K. V. Im, B. J. Kuh, W. K. Choo

- 薄膜() (座長) 徳光 永輔 (東京工業大学) 16:15--17:15
- (26-T-39) Sr 欠損 Bi 過剰 SBT(Bi_{2.2}Sr_{0.8}Ta₂O₉)の電気特性
(ソニー、*北大理) 田中均洋、 広中克行、 小野寺彰*

- (26-T-40) ECRプラズマCVD法によるSrBi₂Ta₂O₉薄膜の直接低温合成とその電気特性評価
(東工大総合理工学研) 額賀 紀全、三矢 昌俊、舟窪 浩
- (26-T-41) Metal-Organic Chemical Vapor Deposition of Ferroelectric SrBi₂Ta₂O₉ Thin Films
(AIXTRON, *Symetrix, **Panasonic Technologies) M. Schumacher, D. Burgess, J. Lindner, F. Schienle, H. Juergensen, S. Narayan*, L. McMillan*, C. Paz de Araujo*, K. Uchiyama**, T. Otsuki**
- (26-T-42) Ferroelectric Sr₂(Nb,Ta)₂O₇ Thin Films Prepared by Chemical Solution Deposition
(Yeungnam Univ.) C. Y. Kim, C. Y. Koo, D. C. Woo, H. Y. Lee
- 基礎() (座長) 山本 孝 (防衛大学校) 9:00--10:15
- (26-B-1) ペロブスカイト酸化物の電子状態と強誘電性
(セイコーエプソン、*広大) 宮澤 弘、名取 栄治、宮下 悟、下田 達也、石井 史之*、小口 多美夫*
- (26-B-2) ビスマス層状ペロブスカイトSBT高温相の結晶構造
(北大理、*筑波大、**北海学園工、***北大工) 小野寺 彰、久保 孝行、吉尾 圭司、小島 誠治*、山下 晴康**、高間 俊彦***
- (26-B-3) 超急冷法により作成したアモルファスBi₄Ti₃O₁₂の結晶化の観察
(いわき明星大理工、*明星大理工、**筑波大物質工学) 高重 正明、濱崎 真一、高橋 義夫、清水 文直、山口 俊久*、小島 誠治**
- (26-B-4) 走査型非線形誘電率顕微鏡によるナノメータ分極ドメインとトポグラフィの同時観測
(東北大電気通信研) 小田川 裕之、長 康雄
- (26-B-5) PbTiO₃薄膜の誘電特性に及ぼすNb添加の効果 - ラマン分光法による解析 -
(静岡大、*湘南工大) 符 徳勝、大野 智也、小川 健、鈴木 久男、石川 賢司、林 卓*
- 基礎() (座長) 高重 正明 (いわき明星大学) 10:30--12:00
- (26-B-6) BaTiO₃粒子の強誘電性に及ぼすサイズ効果
(防衛大学、*京大工) 山本 孝、新居 裕丈、森分 博紀*
- (26-B-7) 高分解能顕微ブリルアン散乱によるリラクサー強誘電体の研究
(筑波大工) 江 福明、小島 誠治
- (26-B-8) リラクサー強誘電体の長距離秩序発達
(*早大理工、**早大理工総研、***東工大理工) 藤城 興司*、上江州 由晃**、山田 安定**、森 茂生***、山本 直紀***
- (26-B-9) Pb(Zn_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃系における相図とラマン散乱
(名大工、*岐阜大工、**愛知淑徳大) 岩田 真、星野 秀隆、折原 宏、大和 英弘*、安田 直彦*、石橋 善弘**

(26-B-10) Neutron Diffraction Studies of $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$ Ceramics
(Microelectronics and Materials Physics Laboratories, *Studsvik Neutron Research Laboratory, ** Materials and Structures Laboratory) J. Frantti, J. Lappalainen, S. Eriksson*, V. Lantto, S. Nishio**, M. Kakihana**, H. Rundlöf*

(26-B-11) Probing of Nano-Scaled Nonstoichiometric 1:1 Ordering in Relaxor Ferroelectric Lead-Based Complex Perovskite Compounds by Raman Spectroscopy
(Korea Institute of Science and Technology) B.-K. Kim

マイクロ波材料 (座長) 脇野 喜久男 (株式会社村田製作所) 13:15--14:45

(26-M-1) 第一原理法による $Ba(B^{12+}_{1/3}B^{15+}_{2/3})O_3$ 複合ペロブスカイト形マイクロ波誘電体の規則-不規則転移およびその特性への影響
(TDK, *マサチューセッツ工科大学) 高橋 毅, E. J. Wu*, G. Ceder*

(26-M-2) $Ba_4(Nb_{1-y}Bi_y)_{9+1/3}Ti_{18}O_{54}$ 擬似タングステンブロンズ型固溶体のマイクロ波誘電特性
(名工大材料, *大研化学工業) 大川 隆*, 今枝 雅樹, 大里 齊

(26-M-3) 固相反応法により合成された $Y_2(Ba_{1-x}Sr_x)(Cu_{1-y}Zn_y)O_5$ 固溶体のマイクロ波誘電特性と結晶構造
(名城大理工, *名工大) 菅 章紀, 小川 宏隆, 横田 修平, 大里 齊*

(26-M-4) Microwave Dielectric Characteristics of the $Ca_{2/5}Sm_{2/5}TiO_3-Li_{1/2}Nd_{1/2}TiO_3$ Ceramics
(Yonsei Univ., *Kyonggi Univ.) W. S. Kim, K. H. Yoon, E. S. Kim*

(26-M-5) Terahertz Response of Bulk $Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3})O_3$
(National Tsing-Hua Univ.) T.R. Tsai, M.H. Liang, C.C. Chi, I.N. Lin

(26-M-6) 水熱合成法による $AgGaS_2$ 結晶合成とその評価
(山口大工, *三菱マテリアル, **東北大理) 小松 隆一, 渡邊 紀子*, 駒井 栄治*, 北風 嵐**, 池田 攻

光応用 (座長) 上江洲 由晃 (早稲田大学) 15:00--16:00

(26-O-1) $K_3Li_{2-x}Nb_{5+x}O_{15+2x}$ 単結晶ファイバーの直径制御
(富山県立大工) 松倉 誠, 村上 順一, 唐木 智明, 安達 正利

(26-O-2) Cu:KNSBN結晶を利用した半共振器型自己励起位相共役鏡
(静岡大理工) 土井 公人, 佐々木 彰

(26-O-3) $MgO-LiNbO_3$ ドメイン反転SHG結晶を用いた青、緑色固体レーザー
(富士写真フィルム) 原田 明憲, 二瓶 靖和, 岡崎 洋二, 神山 宏二

(26-O-4) ホール位置の温度依存性

(久留米大物理) 鶴岡 富士雄

圧電材料() (座長) 安達 正利 (富山県立大学) 16:15--17:15

(26-P-17) フッ素系高分子強誘電体の分極反転スイッチング現象

(山形大工) 今野 篤志、志賀 一喜、鈴木 秀茂、香田 智則、池田 進

(26-P-18) 電子輻射によるP(VDF/TrFE)共重合体ポリマーの相転移

(富山県立大工、*ペンシルベニア州大材料科学研) 唐木 智明、周 宜錦*、クロス エリク*

(26-P-19) PVDFのゲル化を利用し作製したPZNT/PVDF複合体薄膜とその圧電特性

(山形大工、*小林理研、**東芝) 田實 佳郎、米沢 雅人、佐藤 亮、富山 博之、伊達 宗宏*、深田 栄一*、山下 洋八**

(26-P-20) 反応性イオンエッチングを用いたバルク圧電セラミックスの加工と複合圧電体への応用

(*オリンパス光学、東北大) 若林 勝裕*、安部 隆、李 興華、王 詩男、江刺 正喜

チュートリアル (座長) 奥山 雅則 (大阪大学大学院) 17:30--18:30

(26-TU-1) 強誘電体薄膜のエピタキシャル成長と欠陥構造

(太陽誘電) 藤本 正之

5月27日(土)

圧電応用 (座長) 高橋 貞行 (日本電気(株)) 9:00--10:30

(27-A-1) 積層セラミック・コンデンサの鉛レス電気機械変換子への応用について

(山形大工) 城野 良幸、富川 義郎

(27-A-2) 大振動振幅時の電氣的等価回路定数を用いた圧電振動子の跳躍・降下現象の解析

(新潟職能短大、*東工大・精研、**日本電気) 梅田 幹雄、中村 健太郎*、高橋 貞行**、上羽 貞行*

(27-A-3) SH波を用いた強誘電性液晶の電気粘性効果の測定

(*防衛大学、**阪大工) 井上 勝**、森武 洋*、戸田 耕司*、吉野 勝美**

(27-A-4) 新しい非破壊型圧電ウエハ音速評価法

(三菱マテリアル) 簡 春雲、坪井 敦、宇田 聡

(27-A-5) 圧電膜を用いた振動ジャイロの駆動特性

(東北大工、*東北工業技術研究所) 李 成浩、鈴木 学、江刺 正喜、飯島 高志*

(27-A-6) 潤滑された超音波モータ摩擦駆動面の挙動観察

(東工大精密工学研) 前野 清元、石井 孝明、中村 健太郎、上羽 貞行

薄膜() (座長) 高須 秀視 (ルーム) 10:45--12:30

- (27-T-43) (Pb,La)(Zr,Ti)O₃,Y₂O₃を用いたMFIS構造の作製と評価
(東工大 精密工学研、*東工大 フロンティア研) 徳光 永輔、高橋 大輔、石原 宏*
- (27-T-44) MFIS構造におけるエピタキシャルCeO₂/YSZバッファー層の結晶構造と電気的特性に及ぼすYSZ膜厚の影響
(東大理工) 山田 智明、脇谷 尚樹、篠崎 和夫、水谷 惟恭
- (27-T-45) The Study of Crystallization in PZT/PT Thin Films on Mg₂TiO₄ Buffer Layer for MFIS Structure
(Keimyung Univ.) C.-H. Lee, J.-H. Yeom
- (27-T-46) Bi₂SiO₅/Si構造の作製と評価
(*芝浦工大工、**芝浦工大先端研、***八戸工大工) 山口 正樹*,**, 平木 康嗣*, 長友 隆男**, 増田 陽一郎***
- (27-T-47) PLD-YMnO₃薄膜の成長初期過程
(大阪府大工) 伊藤 大輔、藤村 紀文、覚野 浩介、伊藤 太郎
- (27-T-48) Sulfur系カルコゲナイド強誘電体薄膜の形成とその強誘電特性
(大阪大学産研) 堀田 育志、六田 英治、田畑 仁、小林 光、川合 知二
- (27-T-49) エピタキシャルBi₄Ti₃O
薄膜によるMFIS構造の電気特性
(電総研、*日本プレジジョンサーキット) 右田 真司、熊 四輩、坂巻 和男*、太田 裕之、垂井 康夫、酒井 滋樹